明細書

流体混合装置及び切削装置

5 技術分野

本発明は、2つの流体を所望の混合比率で混合させることができる流体混合装置及びその流体混合装置を搭載した切削装置に関する。

背景技術

20

10 切削装置、研磨装置等の各種の加工装置においては、加工品質向上のために加工時に被加工物に対して加工水が供給されて加工が行われる。例えば、第4図に示すように高速回転する回転ブレード18が被加工物、例えば半導体ウェーハWに切り込んで切削を行う切削装置50においては、流入部23に切削水を供給し、半導体ウェーハWと回転ブレード18との接触部に切削水供給ノズル20から加工水である切削水が供給されて切削が行われる。また、噴出部21から切削水を噴出させることにより切削により生じた切削屑を除去することも行われている。

このような切削水としては純水が用いられることもあるが、純水は比抵抗値(抵抗率)が大きいために摩擦によって静電気が発生して半導体ウェーハWに帯電しやすく、特に被加工物が半導体ウェーハの場合には静電気の帯電により著しい品質の低下をもたらすことから、比抵抗値を小さくして静電気の発生を未然に防止し、除電する必要がある。

そこで、例えば特開2001-30170号公報に開示された加工水生成装置 のように、純水に二酸化炭素を混合させることにより比抵抗値を大きくして導電 性が増した加工水を使用することにより静電気の発生を防止することとしている。

25 一方、二酸化炭素の濃度が高くなって酸性度が高くなると、回転ブレード18 が腐食して寿命を低下させたり、半導体ウェーハ上に形成されたボンディングパ ッドが腐食して最終的な半導体チップの品質を低下させたりするという問題もあるため、上記公報に開示された発明においては、バルブの調整によって流量をコントロールすることにより、比抵抗値が適正な値に保たれるような工夫が施されている。

5 しかしながら、例えば半導体ウェーハの切削を行うにあたっては、静電気の帯電を防止することができ、かつ回転ブレード及びボンディングパッド等の腐食を防止するために適正な比抵抗値は Ο. 5 ΜΩ・cm~2. 0 ΜΩ・cmと極めて狭い範囲であることが経験上認識されているが、比抵抗値をこのような範囲に設定し維持するためには、高価な微調整バルブを用い、流量を高精度に調整することが必要となるため、比抵抗値を所望の値とすることが困難であるだけでなく、高価な微調整バルブを用いる必要があり、装置のコストが高騰するという問題もある。このような問題は、切削装置のみならず、加工水を用いる加工装置が共通に有する問題でもある。

従って、加工水を用いる加工においては、経済的な方法で、加工水の比抵抗値 15 を高精度に所望の値に設定できるようにすることに課題を有している。

発明の開示

20

25

上記課題を解決するための具体的手段として本発明は、第一の流体と第二の流体とを混合させる混合装置であって、第一の流体を供給する第一流体供給路と、第二の流体を供給する第二流体供給路と、第一の流体と第二の流体とを混合させて混合流体を生成する混合部とを含み、第一流体供給路が流量比調整部を介して第一経路と第二経路とに分岐し、第二経路が分岐部において流量比率が予め設定された第三経路に分岐し、第三経路が混合部に連結され、混合部には第二流体供給路及び第四経路が連結され、混合部において第三経路から流入する第一の流体と第二流体供給路から流入する第二の流体とを混合させて生成された混合流体を第四経路に流出させ、第四経路が分岐部より下流側の第二経路または第一経路に

合流し、第二経路が第一経路に合流する流体混合装置を提供する。

そしてこの流体混合装置は、分岐部において、第三経路を流れる第一の流体の流量が第二経路を流れる第一の流体の流量の1/50~1/100になるように調整されること、第一の流体は純水であり、第二の流体は二酸化炭素であることを付加的要件とする。

このように構成される流体混合装置によれば、流量比調整部及び分岐部における流量の調整により、高価な微調整バルブ等を用いなくても、高精度に所望の濃度の混合流体を生成することができる。

また、第一の流体が純水であり、第二の流体が二酸化炭素である場合には、二 10 酸化炭素濃度に基づき比抵抗値が定まるため、所望の比抵抗値を有する炭酸水を 生成することができる。

更に本発明は、被加工物を保持するチャックテーブルと、チャックテーブルに保持された被加工物を切削する切削手段と、上記の流体混合装置とを少なくとも備えた切削装置であって、切削手段が、チャックテーブルに保持された被加工物を切削する回転ブレードと、被加工物の切削箇所に切削水を供給する切削水供給ノズルとを少なくとも備え、切削水供給ノズルからは、流体混合装置によって生成された切削水が切削箇所に救急される切削装置を提供する。

このように構成される切削装置によれば、最適な比抵抗値を有する炭酸水を生成して切削水として使用することができる。

20

15

5

図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係る切削装置の一例を示す斜視図である。

第2図は、本発明に係る流体混合装置の構成の一例を示す説明図である。

第3図は、二酸化炭素濃度と比抵抗値との関係を示すグラフである。

25 第4図は、切削水を供給しながら半導体ウェーハを切削する様子を示す斜視図である。

15

20

25

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施の形態として、第1図に示す切削装置10において用いられる切削水の比抵抗値を調整する流体混合装置について説明する。なお、従来例と同様に構成される部位については同一の符号を付して説明することとする。

第1図の切削装置10は、各種の板状物を切削する装置であり、例えば半導体ウェーハWをダイシングする場合には、保持テープTを介してフレームFに保持された半導体ウェーハWがカセット11に複数収容される。

そして、搬出入手段 1 2 が + Y方向に移動してその半導体ウェーハWを挟持し、 10 - Y方向に移動してから挟持を解除することにより、半導体ウェーハWを仮置き 領域 1 3 に載置する。

仮置き領域13に載置された半導体ウェーハWは、第一の搬送手段14を構成する吸着部14aに吸着され、吸着部14aが旋回動してチャックテーブル15の直上に位置付けられ、そこで吸着を解除することによりチャックテーブル15に載置され、吸引保持される。

チャックテーブル15はX軸方向に移動可能となっており、その移動経路の上方には、アライメント手段16が配設されている。このアライメント手段16には、Y軸方向に移動可能な撮像手段17を備えており、チャックテーブル15の+X方向の移動及び撮像手段17のY軸方向の移動により半導体ウェーハWの表面を撮像し、予めメモリに記憶されたキーパターン画像と撮像した画像とのパターンマッチング処理を行うことにより切削すべきストリートを検出することができる。

回転ブレード18を備えた切削手段19は、撮像手段17と一体に形成され、 一体となってY軸方向に移動可能となっている。また、回転ブレード18は、撮像手段17とY座標が等しく、両者はX軸方向において一直線上に位置する。

従って、アライメント手段16によって切削すべきストリートが検出されると、

そのストリートと回転ブレード18とのY軸方向の位置合わせが自動的になされる。そして、半導体ウェーハWを保持するチャックテーブル15が更に+X方向に移動し、回転ブレード18が高速回転しながら切削手段19が下降して、検出されたストリートに切り込むことにより、当該ストリートが切削される。

5 そして、チャックテーブル15をX軸方向に往復移動させると共に切削手段1 9をストリート間隔ずつY軸方向に割り出し送りしながら切削を行うと、同方向 のすべてのストリートが切削される。

更に、チャックテーブル 1 5 を 9 0 度回転させてから上記と同様に切削を行うと、すべてのストリートが切削されてダイシングされ、個々の半導体チップに分10割される。

上記のようにして行う切削の際は、第2図に示すように、回転ブレード18の両側に配設された切削水供給ノズル20から、回転ブレード18と半導体ウェーハWとの接触部に対して冷却のための加工水である切削水が供給される。

また、回転ブレード18のX軸方向の延長線上には、切削水を噴出する噴出部 21が形成されており、噴出された切削水によって滞留した切削水が除去される。 切削水供給ノズル20及び噴出部21から流出する切削水は、流体混合装置30において生成され、ブレードカバー22の上部に設けた流入部23を介して流入する。

流体混合装置30には、第一の流体を蓄えた第一の流体源31と、第二の流体 20 を蓄えた第二の流体源32とを備えている。

第一の流体源31には開閉バルブ33を介して第一流体供給路34が連結されている。また、第一流体供給路34には流量計35が連結され、第一流体供給路34を流れる第一の流体の量を計測し、その量に基づいて開閉バルブ33の開閉を調整することができる。

25 第一流体供給路34の下流側には流量比調整部36が連結されており、流量比調整部36には第一経路37及び第二経路38が連結されている。流量比調整部

15

20

25

36は、第一の流体を第一経路37と第二経路38とに所望の割合で分配することができるバルブである。

第二経路38は、分岐部39において更に第三経路40に分岐している。第二 経路38と第三経路40との流量の比率は、例えば第二経路38を構成するパイプの内径と第三経路40を構成するパイプの内径との比率により予め設定されており、バルブ等を用いることなく、高精度に所望の比率に設定することができる。例えばここでは、第三経路40に流れ出る第一の流体の量を、第二経路38から流れてくる第一の流体の量の1/50~1/100に調整することができる。

第三経路40は混合部41に連結されており、第三経路40を流れる第一の流 10 体は混合部41に流入する。また、混合部41には、圧力調整バルブ42を介し て第二流体供給路43が連結されており、第二流体供給路43は第二の流体源3 2に連結されている。

第二の流体源32には第二の流体が蓄えられており、開閉バルブ32aの調整によって流量を調整すると共に、圧力調整バルブ42の調整によって第二の流体を混合部41に送り込む際の圧力を調整することができる。

混合部41においては、第三経路40から流入した純水と第二流体供給路43 から流入した第二の流体とが混合され、流入量に応じた濃度の混合流体が生成される。

混合部41において生成された混合流体は、第四経路44に流出する。第四経路44は、分岐部39より下流側において第二経路38に合流し、第一の流体と混合される。なお、必要に応じて第四経路44を第一経路37に直接連結し、合流させてもよい。

第四経路44が合流した第二経路38は第一経路37と合流し、第一の流体と 第二の流体とが更に混合された混合流体が生成される。この混合流体の比抵抗値 は、第一経路37に設けた比抵抗値計45によって計測することができる。

以下では、第一の流体源31に蓄えられた第一の流体が純水であり、第二の流

15

体源32に蓄えられた第二の流体が二酸化炭素であり、純水と二酸化炭素とを混合させて、比抵抗値が0.5 MΩの炭酸水を生成して切削水として用いる場合を例に挙げて説明する。

第一の流体源31に蓄えられた純水は、開閉バルブ33において流量が調整され第一流体供給路34を通って流量比調整部36に流入する。流量比調整部36においては、流入した純水の1/3が第二経路38に流出し、残りが第一経路37に流出するように設定する。

一方、分岐部39においては、第二経路38を流れる純水のうち、1/50が 第三経路40に流れ、残りが第二経路38に流れるように予め設定されている。

10 流量比調整部36及び分岐部39を上記のように設定しておくことにより、第 三経路40から混合部41に流入する純水の量は、第一流体供給路34を流れる 純水の1/150 { (1/3) × (1/50) } となる。

一方、第二の流体源32からは混合部41に対して二酸化炭素が供給され、開閉バルブ32aにおいて流量を調整することにより、混合部41においては二酸化炭素濃度が300ppmの炭酸水を生成する。

生成された炭酸水は、第四経路44を経て第二経路38と合流し、純水と混合される。第二経路38においては炭酸水の49倍の量の純水が流れており、合流により炭酸水が50倍に薄められるため、ここで二酸化炭素濃度は6ppm {300ppm×(1/50)}となる。

20 また、上記合流により二酸化炭素濃度が6ppmとなった炭酸水は第二経路38を流れ、第一経路37と合流して更に純水と混合される。第一経路においては、第二経路38を流れる炭酸水の2倍の量の純水が流れており、合流により炭酸水が3倍に薄められるため、ここで二酸化炭素濃度は2ppm [6ppm×(1/3)]となる。

25 純水中の二酸化炭素濃度と比抵抗値との間には、第3図のグラフに示された関係が成立することが実験により証明されている。このグラフによれば、炭酸水の

10

15

20

二酸化炭素濃度が300ppmであるときは、比抵抗値はおよそ $0.05M\Omega$ である。一方、二酸化炭素濃度が2ppmであるときは、比抵抗値はおよそ $0.5M\Omega$ である。

従って、炭酸水の二酸化炭素濃度を300ppmから2ppmまで下げることによって、比抵抗値は0.05M Ω から0.5M Ω となり、所望の比抵抗値の炭酸水となる。このことは、比抵抗値計45における計測値によって確認することができる。

このように、従来は高価な微調整バルブを用いないと150分の1というような微調整ができなかった比抵抗値を、3分の1程度の調整ができる安価なバルブ等からなる流量比調整部36で高精度に所望の値とすることができる。

こうして生成された炭酸水は、第一経路37から切削水流入部23に流入し、切削水供給ノズル20から流出すると共に、噴出部21から噴出される。この切削水は、二酸化炭素を混合させて所望の比抵抗値としているために適度な導電性を有する。従って、摩擦による静電気が生じにくく、半導体ウェーハWに静電気が帯電するのを防止することができると共に、酸性度が高すぎることもないため、半導体ウェーハWや回転ブレード18の腐食を防止することもできる。

そこで、例えば流量比調整部36において第二経路38に流出する純水の量が 1/7.5になるように調整し、更に分岐部39においては第二経路38を流れ る純水の1/50が第三経路を介して混合部41に流入するようにする。

そして、混合部41において300ppmの炭酸水を生成して第四経路の流出 25 させると、第二経路38と合流した際に二酸化炭素濃度が1/50となって6ppmとなり、第二経路38が第一経路37に合流することにより更に1/7.5

20

に薄められるため、第一経路37から切削水流入部23に流入する切削水の二酸化炭素濃度は0.8ppmとなって比抵抗値が1MΩとなる。

このように、第2図に示した流体混合装置30においては、分岐部39において流量比率が1/50に設定されているので、流量比調整部36において大まかな流量調整を行うと、所望の比抵抗値を有する炭酸水を生成することができる構成となっている。なお、分岐部39における流量比を1/100に設定してもよいし、3箇所以上に分岐点を設けてそのそれぞれについて流量比率を設定するようにしてもよい。また、第一の流体及び第二の流体は、純水、二酸化炭素には限られない。

10 また、本実施の形態においては、流体混合装置30を切削装置10に搭載して 切削水を生成する場合について説明したが、他の加工装置で使用する加工水を生 成する場合にも適用することができる。例えば、半導体ウェーハの面を研削する 研削装置においては、研削品質の向上のために研削砥石と半導体ウェーハとの接 触面に研削水を供給する必要があり、この研削水も流体混合装置30を用いて生 15 成することができる。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明に係る流体混合装置によれば、流量比調整部及び 分岐部における流量の高精度な調整により、高価な微調整バルブ等を用いなくて も高精度に所望の濃度の混合流体を生成することができるため、装置のコストを 低減することができる。

また、第一の流体が純水であり、第二の流体が二酸化炭素である場合には、二酸化炭素濃度に基づき比抵抗値が定まるため、所望の比抵抗値を有する炭酸水を 生成することができ、加工のために最適な加工水を生成することができる。

25 更に、本発明に係る流体混合装置によれば、純水に二酸化炭素を混合させることにより最適な比抵抗値を有する炭酸水を生成して切削水として使用することが

できるため、コストの高騰を伴うことなく、切削時の静電気の発生、除電及び回 転ブレード及び被加工物の腐食を防止することができる。

請求の範囲

1. 第一の流体と第二の流体とを混合させる流体混合装置であって、

第一の流体を供給する第一流体供給路と、第二の流体を供給する第二流体供給 5 路と、該第一の流体と該第二の流体とを混合させて混合流体を生成する混合部と を含み、

該第一流体供給路は、流量比調整部を介して第一経路と第二経路とに分岐し、 該第二経路は、分岐部において流量比率が予め設定された第三経路に分岐し、 該第三経路は、該混合部に連結され、

10 該混合部には該第二流体供給路及び第四経路が連結され、

または第2項に記載の流体混合装置。

該混合部において該第三経路から流入する第一の流体と該第二流体供給路から 流入する第二の流体とを混合させて生成された混合流体を該第四経路に流出させ、 該第四経路は、該分岐部より下流側の第二経路または第一経路に合流し、 該第二経路は該第一経路に合流する

15 流体混合装置。

20

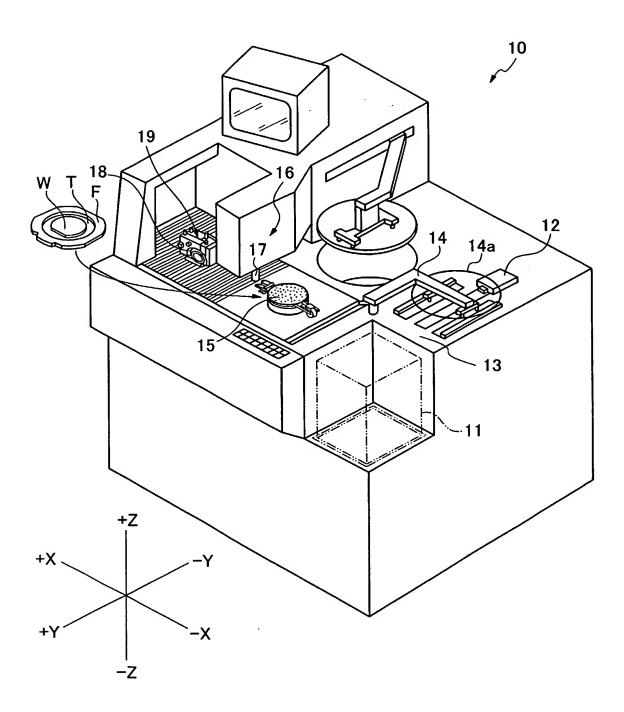
2. 該分岐部においては、第三経路を流れる第一の流体の流量が、第二経路を流れる第一の流体の流量の1/50~1/100になるように調整される請求の範囲第1項に記載の流体混合装置。

3. 第一の流体は純水であり、第二の流体は二酸化炭素である請求の範囲第1項

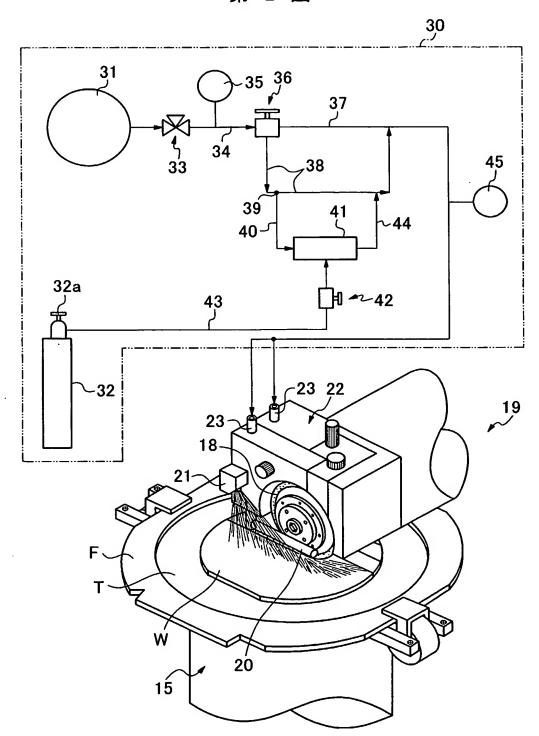
4. 被加工物を保持するチャックテーブルと、該チャックテーブルに保持された 25 被加工物を切削する切削手段と、請求項1、2または3に記載の流体混合装置と を少なくとも備えた切削装置であって、 該切削手段は、該チャックテーブルに保持された被加工物を切削する回転ブレードと、該被加工物の切削箇所に切削水を供給する切削水供給ノズルとを少なくとも備え、

該切削水供給ノズルからは、該流体混合装置によって生成された切削水が該切 5 削箇所に供給される切削装置。

第 1 図

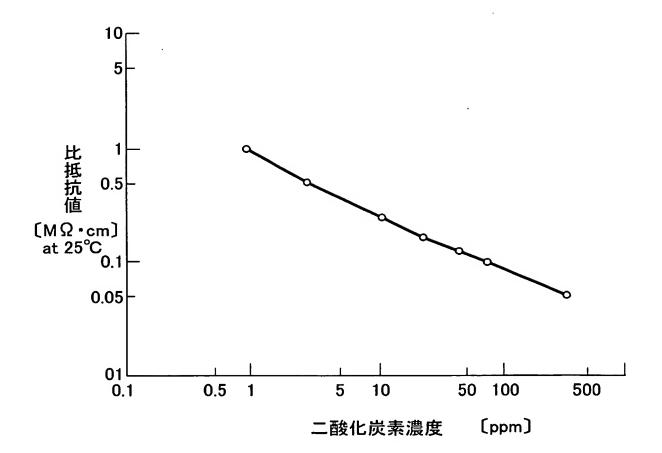


第 2 図



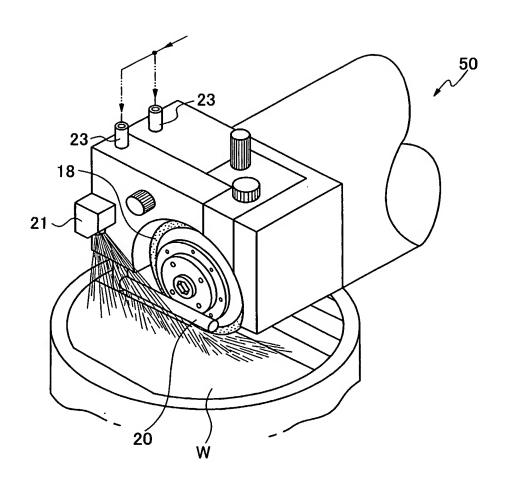
Ų

第 3 図



 $^{\prime}$

第 4 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/01237

| A. CLASS | A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B24B55/02, B01F3/04, H01L21/304 | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | | |
| B. FIELDS | SEARCHED | | | | | |
| Minimum do Int.(| Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B24B55/02, B01F3/04, H01L21/304, B28D5/00 | | | | | |
| Jitsu | Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 | | | | | |
| Electronic da | ata base consulted during the international search (name | of data base and, where practicable, sear | rch terms used) | | | |
| | | | | | | |
| C. DOCU | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where app | propriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | | |
| X A | JP 7-204524 A (Fujitsu Ltd.) 08 August, 1995 (08.08.95), Par. Nos. [0036] to [0037]; F (Family: none) | | 1-2 3-4 | | | |
| А | US 6158721 A (Dainippon Ink 12 December, 2000 (12.12.00), Full text; all drawings & JP 10-324502 A & GB & DE 19853638 A | | 1-4 | | | |
| A | US 5609798 A (MSP CORP.), 11 May, 1997 (11.05.97), (Family: none) | | 1-2 | | | |
| × Furth | er documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | | | | |
| * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 07 May, 2003 (07.05.03) Date of mailing of the international search 20 May, 2003 (20.05.03) | | | | | | |
| Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office | | Authorized officer | | | | |
| Ecocionile N | 1= | Telephone No. | | | | |



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/01237

| | citation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No | | |
|-------------|--|-----|--|
| Category* | EP 370870 A1 (L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR | 1-2 | |
| A | L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE), 30 May, 1990 (30.05.90), & JP 2-273525 A & EP 370870 A1 & US 5054309 A | 1-2 | |
| A | EP 1055445 A2 (Sanyo Electric Co., Ltd.), 29 November, 2000 (29.11.00), Par. No. [0174] & JP 2001-38352 A & US 2002/6769 A1 | 3-4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Int Cl7 B24B55/02, B01F3/04, H01L21/304

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int Cl7 B24B55/02, B01F3/04, H01L21/304, B28D5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. 関連する | C. 関連すると認められる文献 | | | |
|---------|--|----------|--|--|
| 引用文献の | | 関連する | | |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | | |
| X | JP 7-204524 A (富士通株式会社) 1995.08.08 段落【0036】~段落【0037】、第4図(ファミリーなし) | 1 – 2 | | |
| A | | 3 – 4 | | |
| A | US 6158721 A (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC.) 2000.12.12、全文、全図 & JP 10-324502 A &GB 2343637 A & DE 19853638 A | 1 – 4 | | |
| A | US 5609798 A(MSP CORPORATION) 1997.05.11 (ファミリーなし) | 1-2 | | |

x C 欄の続きにも文献が列挙されている。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

1

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/01237

| C(続き). | 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------|---|------------------|--|
| 引用文献の カテゴリー* | | 関連する 請求の範囲の番号 | |
| A | EP 370870 A1 (L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE) 1990.05.30 & JP 2-273525 A & EP 370870 A1 & US 5054309 A | 1 — 2 | |
| A | EP 1055445 A2 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) 2000.11.29、段落[0174] &JP 2001-38352 A &US 2002/6769 A1 | 3 – 4 | |
| | | .0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |